⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-282726

(9) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月20日

G 02 F 1/1337

5 2 5

8806-2H

審査請求 未請求 請求項の数 7 (全9頁)

図発明の名称 液晶配向膜および液晶表示素子

②特 願 平1-106195

②出 願 平1(1989)4月25日

滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業 明 @発 者 幡 野 彦 場内 Ξ 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業 ②発 明 者 桜 井 雄 場内 @発 明 者 利 夫 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業 吉 村 場内 72)発 明 者 Œ 忠 則 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業 場内

人 東 レ 株 式 会 社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

明細・白

- 1. 発明の名称 液晶配向膜および液晶表示素子
- 2. 特許請求の範囲

願

の出

(1) 下記一般式(I)で表わされる繰り返し単位および下記一般式(II)で表わされる繰り返し単位を主成分として含有して成るポリイミドより形成されたことを特徴とする液晶配向膜。

li

0

r は 0 または 1 を示す。 R ¹ は炭素数 4 ~ 2 0 の アルキル基またはフルオロアルキル基を示す。 R ² は四価の有機残基、 R ³ は二価の有機残基を示 す。 m / n の比は 1 / 9 9 ~ 8 0 / 2 0 である。

② 一般式(I)におけるR¹が炭素数4~2 0のフルオロアルキル基である請求項1記載の液 晶配向膜。

(3) 一般式(1)におけるR²が四価の芳香族 残基および/または四価の脂肪族残基である請求 項1記載の液晶配向膜。

(4) 一般式(I) で表わされる繰り返し単位と一般式(II) で表わされる繰り返し単位の構成比m/nの値が5/95~50/50である請求項1記載の液晶配向膜。

(5) 液晶を挟持する一対の平行に配置された透明電極基板の表面に液晶配向膜を設け、該液晶配向膜の表面を一定方向にラピングしてなる液晶表示素子において、該液晶配向膜として下記一般式

- (1) で表わされる繰り返し単位と下記一般式
- (Ⅱ) で表わされる繰り返し単位を主成分として

含有して成るポリイミドを使用することを特徴と する液晶表示素子。

r は 0 または 1 を示す。 R^1 は炭素数 $4 \sim 20$ の r ルキル基またはフルオロアルキル基を示す。 R^2 は四価の有機残基、 R^3 は二価の有機残基を示す。 m/n の比は $1/99 \sim 80/20$ である。

れを一方向にラビングした液晶配向膜を用いることにより発現させることができる。このような液晶配向膜を備えた液晶素子としては、表示素子以外にも光シャッターや非線形光学効果を利用した波長変換器などの光学素子がある。

TN方式の液晶表示素子はしきい値特性や応答 速度等に欠点があり、近年要求の高まってきた大 容量液晶表示素子には性能面で対応できない。そ こで、急峻なしきい値特性を持ち、コントラスト、 視覚特性などに優れたSTN方式あるいはSBE 方式の液晶表示装置が開発された(T. J. Sc hefferら Appl. Phys. Lett. 45(10), 1021(1984)参照)。

この方式の液晶表示素子では、上下基板間での 液晶分子の配向方向を180°以上ねじる必要が ある。そのため、液晶分子は基板面に対して3° から20°程度の傾斜角度を持って配向していな ければならない。

また、TN方式、STN方式の液晶表示素子に 比べて応答速度の速い強誘電性液晶を利用した液 (6) 一般式(I)におけるR¹ が炭素数4~2 0のフルオロアルキル基である請求項5記載の液 晶表示素子。

(7) 一般式(I)で表わされる繰り返し単位と一般式(II)で表わされる繰り返し単位の構成比」m/nの値が5/95~50/50である請求項5記載の液晶表示素子。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は液晶配向膜およびこれを用いた液晶表示素子、特に液晶分子が基板に対して傾斜角度 (プレチルト角)を持って配向している状態を与 える液晶配向膜および液晶表示素子に関する。

[従来の技術]

液晶表示素子における液晶分子の配向には、垂直、水平、傾斜の3通りがある。従来より広く用いられてきたTN型液晶表示素子における液晶分子の配向は水平配向で液晶分子の配向方向は基板に対して平行であった。このような配向状態はポリイミドなどの有機樹脂膜を基板上に形成し、こ

品表示素子も開発されている(N. A. Clarkら Appl. Phys. Lett. <u>36</u>(1980), 899参照)。強誘電性液晶はその高速応答性に注目され、光ブリンターのシャッターアレイに応用する(オプトロニクス, <u>64</u> (1987), p. 97参照)など、表示素子以外の分野での利用も考えられている

強誘性液晶の配向制御方法の1つとして、液晶分子を基板に対して傾斜させて配向させるという方法が提案されている(T. Uemuraら JAPAN DISPLAY '86 予稿集464 (講演番号12.3)参照)。

有機樹脂膜をラピングするという、従来のTN 方式の液晶表示素子で用いられていた配向方法で は液晶分子と基板とのなす角度(プレチルト角) は0°から高々2°程度である。このように小さ なプレチルト角では、STN方式あるいは強誘 性液晶の傾斜配向を実現することは難しい。そこ で、T.J.SchefferらとT.Uemu raらは、液晶分子を傾斜配向させるために酸化 珪素等の無機斜方蒸箱膜を用いている。また、ポリイミド等の有機樹脂に垂直配向剤を混合することによって、ラビング処理法で傾斜配向を達成する方法も報告されている(特開昭62-262828 号公報、62-262829 号公報、62-291819 号公報参照)。

さらに、フッ素原子を含有するポリイミド等の 有機樹脂膜をラビング処理した液晶配向膜を用い て、大きなプレチルト角を出すという試みもなさ れている(特開昭62-127827号、62-127828号、 63-259515号、63-262620号公報参照)。

[発明が解決しようとする課題]

基板上に無機斜方蒸着膜を形成する方法は、蒸 着装置など特別な装置を必要とすること、作業が 煩雑で量産技術には適さない等の欠点がある。

一方、ポリイミド等の水平配向剤に垂直配向剤を混合した系では、液晶分子の傾斜角の値が不安定であったり、ラビング処理等の製造条件に大きく依存するという問題がある。また、従来の含フッ紫ポリイミドでは含フッ紫成分のプレチルト角の誘起効果が小さく、実用上十分なプレチルト角

r は 0 または 1 を示す。 R 1 は炭素数 4 ~ 2 0 の アルキル基またはフルオロアルキル基を示す。 R 2 は四価の有機残基、 R 3 は二価の有機残基を示 す。 m / n の比は 1 / 9 9 ~ 8 0 / 2 0 である。

本発明は、第2に液晶を挟持する一対の平行に配置された透明電極基板の表面に液晶配向膜を設け、該液晶配向膜の表面を一定方向にラピングしてなる液晶表示素子において、該液晶配向膜として下記一般式(II)で表される繰り返し単位を主成分として含有して成るポリイミドを使用することを

を実現させるためには多量の含フッ素成分を共重合させる必要がある。このようなポリイミドでは、 その接着性改善や耐溶剤性の向上などの諸特性改善のため他の成分を共重合させる場合に大きな制 約となり問題である。

本発明はかかる在来技術の諸欠点に鑑み創案されたもので、その目的は、特殊な装置を必要とせず、かつ液晶配向膜の他の特性を犠牲にすることなく安定で大きな傾斜配向を発現できる液晶配向膜および液晶表示素子を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

すなわち、本発明は第1に、下記一般式 (I) で表わされる繰り返し単位および下記一般式 (Ⅱ) で表わされる繰り返し単位を主成分として含有して成るポリイミドより形成されたことを特徴とする液晶配向膜を提供する。

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 \\
\parallel & \parallel & \parallel \\
C & R & C & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 & \parallel & \parallel \\
0 & 0 & N
\end{pmatrix}$$

とを特徴とする液晶表示素子を提供する。

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 \\
\parallel & \parallel \\
C & R \stackrel{?}{>} C \\
N & 0 \\
0 & 0
\end{pmatrix}$$
(1)

式(I)、(II)において、X は - O - 、 - C O - 、 - C N H - および - C - から選ばれ、 || || || || O O O

rは0または1を示す。R¹ は炭素数4~20の アルキル基またはフルオロアルキル基を示す。R² は四価の有機残基、R³ は二価の有機残基を示 す。m/nの比は1/99~80/20である。 一般式(I)で表わされる繰り返し単位と一般式(II)で表わされる繰り返し単位の構成比m にの値は、1/99~80/20である。好を値がまりである。好りである。好りである。がないないである。があるでである。があることが難しく、一方がでいるでは、でいるでは、でいるなどの問題を生じる場合がある。安定とやポリイミドの機械的あるいは熱のなながしたプレチルト角を得るために好ましくである。アクラックを値は5/95~50/50である。

本発明における、上記一般式(I)で表わされる繰り返し単位および一般式(II)で表わされる繰り返し単位を主成分として含有してなるポリイミドは、後述の一般式(III)で表わされるジアミン化合物の1種または2種以上と、一般式(V)で表わされるテトラカルボン酸二無水物の1種または2種以上を、N, Nージメチルホルムアミド、

$$H_2 N - R_3 - N H_2$$
 (IV)

上記の一般式(Π)、(Π) および(Π) における、 Π 、 Π 、 Π 、 Π 、 Π 、 Π) におけるのと同様である。

一般式(I)および(II)におけるR¹ は炭素数4~20のアルキル基または炭素数4~20のフルオロアルキル基である。炭素数が4未満では液晶配向特性、特に傾斜配向特性が十分でなく、炭素数が20を越えるものにしても液晶配向特性の面で得られるところはほとんどない。より好ましくは炭素数8~16である。

R 1 は直鎖状でも分岐状でもよい。直鎖状のアルキル基としては、n-ブチル基、n-ペンチル基、n-ヘキシル基、n-ヘプチル基、n-オクチル基、n-ノニル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、n-ドデ N. N-ジメチルアセトアミド、N-メチルー2 ーピロリドン、γープチロラクトンなどの極性溶 媒中で反応させることにより、前駆体であるポリ アミド酸溶液の形で合成することができる。

反応温度および時間は特に限定されないが、通常0℃~80℃の温度で1~10時間攪はんすることによって、固有粘度が0.1~4.0の範囲にあるポリアミド酸溶液を調整することができる。

また、かかるポリアミド酸溶液をそのまま、あるいはトルエン、キシレンなどの溶媒を共存させて共沸脱水条件で100℃以上に加熱することによって、部分的あるいは完全にイミド閉環したポリイミド溶液を得ることも、一般式(I)と(II)の繰り返し単位を適当に選ぶことによって可能である。

さらに、かかるイミド閉環反応はピリジン/無水酢酸などの閉環反応促進触媒の共存下で行うこともできる。

$$H_2 N \longrightarrow N H_2 \qquad (II)$$

シル基、1-テトラデシル基、1-ペンタデシル基、 n-ヘキサデシル基、n-オクタデシル基、n-エイコ シル基などを例示することができる。分岐状のア ルキル基としては、イソプチル基、sec-プチル基、 lerl- プチル基、1-メチルプチル基、2-メチルブ チル甚、3-メチルプチル基、1-メチルペンチル基、 2-メチルペンチル基、3-メチルペンチル基、4-メ チルペンチル基、1-メチルヘキシル基、2-メチル ヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキ シル基、5-メチルヘキシル基、1-メチルヘプチル 墓、2-メチルヘプチル基、3-メチルヘプチル基、 4-メチルヘプチル基、5-メチルヘプチル基、6-メ チルヘプチル基、1-メチルオクチル基、2-メチル オクチル基、1-メチルオクチル基、1-メチルオク チル基、\$-メチルオクチル基、6-メチルオクチル 基、1-メチルオクチル基、1-メチルノニル基、2-メチルノニル基、3-メチルノニル基、4-メチルノ ニル基、5-メチルノニル基、6-メチルノニル基、 1-メチルノニル基、1-メチルノニル基、1-メチル デシル基、2-メチルデシル基、3-メチルデシル基、

4-メチルデシル基、5-メチルデシル基、6-メチル デシル基、7-メチルデシル基、8-メチルデシル基、 9-メチルデシル基、1-メチルドデシル基、2-メチ ルドデシル基、3-メチルドテシル基、4-メチルド デシル基、5-メチルデシル基、6-メチルドデシル 基、7-メチルドデシル基、8-メチルドデシル基、 9-メチルドデシル基、10-メチルドデシル基、11 - メチルドデシル基、1-メチルテトラデシル基、 2-メチルテトラデシル基、3-メチルテトラデシル 基、4-メチルテトラデシル基、5-メチルテトラデ シル基、6-メチルテトラデシル基、1-メチルテト ラデシル基、B-メチルテトラデシル基、B-メチル テトラデシル基、10- メチルテトラデシル基、11 - メチルテトラデシル基、12- メチルテトラデシ ル基、13- メチルテトラデシル基、1-メチルヘキ サデシル基、2-メチルヘキサデシル基、3-メチル ヘキサデシル基、4-メチルヘキサデシル基、5-メ チルヘキサデシル基、6-メチルヘキサデシル基、 7-メチルヘキサデシル基、8-メチルヘキサデシル 基、9-メチルヘキサデシル基、10- メチルヘキサ

デシル基、11-メチルヘキサデシル基、12-メチルヘキサデシル基、13-メチルヘキサデシル基、16-メチルヘキサデシル基、15-メチルヘキサデシル基、1-メチルオクタデシル基、2-メチルオクタデシル基、6-メチルオクタデシル基、5-メチルオクタデシル基、6-メチルオクタデシル基、10-メチルオクタデシル基、11-メチルオクタデシル基、12-メチルオクタデシル基、12-メチルオクタデシル基、14-メチルオクタデシル基、14-メチルオクタデシル基、16-メチルオクタデシル基、15-メチルオクタデシル基、16-メチルオクタデシル基、17-メチルオクタデシル基などを例示することができる。

フルオロアルキル基としては、上記のアルキル基の水素原子の1個以上がフッ素原子で置換されたものが使用可能である。このようなフルオロアルキル基の内で特に好ましく使用できるものとして、ヘプタフルオロブチル基、ノナフルオロー tertーブチル基、パーフルオロブチル基、オク

タフルオロペンチル基、パーフルオロペンチル基、 ノナフルオロヘキシル基、パーフルオロペーキシル 基、パーフルオロヘブチル基、トリデカフルオロヘブチル基、パーフルオロハブチル基、ロスカテル基、ロスカテカフルオロオクチル基、パーフルオロオクチル基、ローフルオロデシル基、パーフルオロデシル基、パーフルオロデシル基、パーフルオロデシル基、パーフルオロテトラデシル基、パーフルオロテトラデシル基、パーフルオロテトラデシル基、パーフルオロテッカーフルオロティーフルオロステッカーフルを ルオクテッカーフルオロエイコシル基なロオクタデシル基、パーフルオロエイコシル基ないできる。

rは0または1である。

一般式(1)、(II.)および(V)においてテトラカルボン酸構造を形成する R² は四価の有機

残基、好ましくは四価の芳香族残基または脂肪族 残基である。好ましく使用できる芳香族テトラカ ルポン酸二無水物の具体例としては、芳香族1核 体としてピロメリット酸、トリフルオロメチルピ ロメリット酸、ビス (トリフルオロメチル) ピロ メリット酸、芳香族2核体として3,3'-4,4'-テト . ラカルボキシジフェニルエーテル、2, 3, 3', 4′-テトラカルボキシジフェニルエーテル、3,3',4,4 ′-ペンソフェノンテトラカルポン酸、2.3.3′.4-ベンソフェノンテトラカルポン酸、3.3'.4.4'-ビ フェニルテトラカルボン酸、2,3,3',4'-ビフェニ ルテトラカルボン酸、3.3'.4.4'-テトラカルボキ シジフェニルメタン、2.3.6.7-ナフタレンテトラ カルボン酸、1.4.5.8-ナフタレンテトラカルボン 酸、1.2.5,6-ナフタレンテトラカルポン酸、2.2-ピス(3.4-ジカルボキシフェニル)プロパン、2. 2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル) ヘキサフル オロプロパン、3,3',4,4'-テトラカルボキシジフ ェニルスルホン、芳香族 4 核体として2, 2-ビス (1-(3.1- ジカルボキシフェノキシ) フェニル)

プロパン、2,2-ビス(4-(3,4-ジカルポキシフェノキシ)フェニル)へキサフルオロプロパン、1,2,1,8-テトラカルポキシペリレンなどを例示することができる。

脂肪族残甚R² を含むテトラカルボン酸二無水物の具体的な例としては、シクロブタンテトラカルボン酸、シクロペンタンテトラカルボン酸、シクロペナサンテトラカルボン酸、1,1,4,4-プタンテトラカルボン酸、2,2,6,6-ヘプタンテトラカルボン酸、3,5,6-トリカルボキシ-2-カルボキシメチルノルボルナン等の二無水物および5-(2,5-ジオキソテトラヒドロフリル)-3-メチル-3-シクロヘキセン-1,2-ジカルボン酸無水物、ビシクロ(2,2,2)-オクト-1-エン,2,3,5,6-テトラカルボン酸などを例示することができる。

一般式(II)および(IV)におけるR³ は二価の有機残基、好ましくは二価の芳香族残基または脂肪族残基である。R³ が二価の芳香族残基である、一般式(IV)のジアミン化合物の具体例としては、芳香族 1 核体としてp-フェニレンジアミン、

m-フェニレンジアミン、o-フェニレンジアミン、 2, 4-ジアミノトルエン、4, 6-ジメチル-m- フェニ _ レンジアミン、1.1-ジアミノメシチレン、1-クロ ロ-B- フェニレンジアミン、(-フルオロ-B- フェ ニレンジアミン、テトラフルオロ-p- フェニレン ジアミン、テトラフルオロ-a- フェニレンジアミ ン、テトラフルオロ-0- フェニレンジアミン、2-ニトロ-9- フェニレンジアミン、芳香族2核体と してペンジジン、4.1'・ジアミノジフェニルエー テル、3,4'・ジアミノジフェニルエーテル、3,3' - ジアミノジフェニルエーテル、3,3'- ジアミノ ジフェニルエーテル、1.1'- ジアミノジフェニル メタン、3.1'- ジアミノジフェニルメタン、3.3' - ジアミノジフェニルメタン、モビ- ジアミノジ フェニルスルホン、3.1'- ジアミノジフェニルス ルホン、3.3' - ジアミノジフェニルスルホン、3. 3'- ジアミノジフェニルスルフィド、3.4'- ジア ミノジフェニルスルフィド、4.11- ジアミノベン ソフェノン、3、4'- ジアミノベンゾフェノン、3、 1' - ジアミノペンゾフェノン、1,1-ビス(4-アミ

ノフェニル) プロパン、2,2-ビス(3-アミノフェ ニル) プロパン、2.2-ピス(4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(3-アミノフ ェニル) ヘキサフルオロプロパン、1,5-ジアミノ ナフタレン、2,6-ジアミノナフタレン、3,3'-ジ メチルベンジジン、3,3'- ジメトキシベンジジン、 3.3'- ジメチル-4.4' - ジアミノジフェニルエー テル、3,3' - ジメチル-4,4' - ジアミノジフェニ ルメタン、芳香族3核体として1.4-ピス(4-アミ ノフェノキシ) ベンゼン、1,3-ピス(4-アミノフ ェノキシ) ベンゼン、1,3-ピス(3-アミノフェノ キシ) ベンゼン、芳香族4核体として、4.1'・ビ ス (4-アミノフェノキシ) ピフェニル、もど- ビ ス (3-アミノフェノキシ) ビフェニル、4.1'- ビ ス (4-アミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、 **↓ l' - ビス (1-アミノフェノキシ) ジフェニルス** ルホン、3.4-ピス(4-アミノフェノキシ)ジフェ ニルスルホン、まイーピス(3-アミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、3.3'- ビス(4-アミノフェ ノキシ) ジフェニルスルホン、3.1′- ビス(3-ア

ミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、2, 2-ビス (4-(4- アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、 2, 2-ビス(4-(3- アミノフェノキシ)フェニル) プロパン、2, 2-ビス(4-(2- アミノフェノキシ) フェニル)プロパン、1, 2-ビス(4-(4- アミノフェノキシ) フェニル)フエニル)ヘキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス(4-(3- アミノフェノキシ)フェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(2-アミノフェノキシ)フェニル)ヘキサフルオロプロパン などを挙げることができる。

R 3 が脂肪族基である、一般式 (IV) のジアミン化合物の具体例としては、1, 4-ジアミノオクタン、1, 6-ジアミノ ドデカン、1, 4-ジアミノ シクロへキサン、ビス (4-アミノシクロへキシル) メタン、ビス (4-アミノ-12- メチルシクロへキシル) メタン、ビス (4-アミノ-13- メチルシクロへキシル) メタン、1, 1-ビス (1-アミノプロピル) テトラメチルジシロキサンなどを例示することができる。R 3 が芳香族脂肪族残甚であるジアミン化合物も

好ましく使用可能であり、このような化合物の具体例としては、p-キシリレンジアミン、m-メタキシリレンジアミンなどを例示することができる。

上記のポリアミド酸またはポリイミド溶液の液 晶表示素子用基板、すなわち透明電極基板上への 塗布は、ポリマ濃度0.01~40重量%、好ま しくは0.1~20重量%溶液を用いて、印刷法、 スピンナー法、ディップ法、スプレー法等の手法 で行うことができる。使用される溶媒は、該ポリ アミド酸またはポリイミドを溶解するものであれ ば制限はないが、好ましく使用できる溶媒の具体 例としては、N, N-ジメチルホルムアミド、N. N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピ ロリドン、γープチロラクトン等を挙げることが できる。これらは単独で使用することもできるが、 他の溶媒と混合して使用することもできる。特に、 メチルセロソルブやブチルセロソルブ、エチルカ ルビトール、エチルセロセルプアセテートなどの ポリイミドの貧溶媒を、上記の溶媒と適当量混合 することによって、該ポリイミド前駆体溶液のガ

その両側に偏光板を配置した構造のもが使用でき る。

本発明の液晶配向膜は液晶表示素子などの表示素子に有効に使用されるものであるが、表示素子以外にも光シャッターや非線形光学効果を利用した波長変換器などの光学素子にも有効に使用できるものである。

[実施例]

以下、実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定される ものではない。

実施例におけるプレチルト角の測定は磁界容量 零位法によって行った (T. J. Sheffer ら J. Appl. Phys. <u>48</u>(5), 1783-(1977) 参照)。

実施例1

4. 4' -ジアミノジフェニルエーテル3. 9 4 g (0. 0197モル) と4 - (1H, 1H, 2H, 2H-パーフルオロデシロキシ) -1, 3 -ジアミノベンゼン1. 25 g (0. 0022モ ラス基板に対する塗布性が著しく改善される場合 がある。

ポリアミド酸溶液を基板に塗布後、100℃~400℃、好ましくは200℃~300℃で加速することにより、対応するポリイミドの被膜がある。これを当業者間知の方法でラビングを開知したプレチルト角配向させることにより、安定したプレチルト角配配がある。部分的または完全にイミド関型を行りが、この場合にはより低い温度、すなわち150℃~250℃でポリイミド膜を得ることが可能である。

なお本発明の液晶表示素子の構造としては特に ・限定されず公知のものが使用できる。一般に2枚 のガラスまたはフィルム基板上に酸化インジウム、 酸化スズ膜等の透明導電膜からなるセグメント電 極を設け、その上に常法により液晶配向膜を形成 し、これらをもって液晶をサンドイッチするとと もに、周辺部をシール剤によって封止し、さらに

上記のようにして得られたポリアミド酸溶液の 組成は、一般式(I)で表わされる繰り返し単位 と一般式(II)で表わされる繰り返し単位の構成 比m/nの値が10/90にに相当する。

ついでこの溶液をNMPとブチルセロソルブ (以下BCと略称する)との混合溶媒で3重量%

溶液になるように希釈した。希釈後の溶液中のN MPとBCとの比率は重量比で7:3であった。 この溶液をスピナーを用いて酸化インジウム・ス ズ膜 (いわゆる I T O 膜) からなる透明電極が形 成されたガラス基板(30mm×33mm)に塗 布した。その後、80℃で15分、ついで250 ℃で1時間加熱処理し、ポリイミド被膜を形成し た。ついで該被膜をナイロン布でラビング処理し た。ラビング処理にはEHC社製ラビングマシン RM-300Hを使用した。 ラビングローラーの 回転速度は800rpm、基板の移動速度は毎秒 100mmであった。その後、8μmのスペーサ を挟んでラビング方向が反平行になるようにセル を組み立て、液晶(ZLI-2293、Merc k 社製)を注入して液晶表示素子を作製した。こ の素子のプレチルト角を測定したところ、5.1 * であり配向状態も良好であった。

また、この液晶表示素子を100℃で1時間加 熱した後室温まで放冷し、再びプレチルド角を測 定したところ、5.1°で熱処理前と変化なく、

機にしてポリアミド酸溶液を調整した。繰り返し 単位の構成比m/nは20/80である。この溶 液を用いて、実施例1と同様の液晶表示素子を作 製したところ、プレチルト角は7.0°で液晶配 向性も良好であった。

実施例4

N,N-ジメチルアセトアミド (以下DMAC と略称する)を溶媒として、ピロメリット酸二無 水物 0. 0119モル、4,4′-ジアミノジフ ェニルエーテルの、0107モルおよび4-(1 H, 1 H, 2 H, 2 H - パーフルオロデシロキシ) -1. 3 - ジアミノベンゼン 0. 0 0 1 2 モルを 0℃で1時間、ついで室温で2時間撹拌して、ポ リアミド酸の10重量%DMCA溶液を得た。緑 り返し単位の構成比m/nは10/90である。 この溶液をDMACとBCとで3重量%になるよ うに希釈した。希釈後のDMACとBCとの重量 比は7対3であった。その後、実施例1と同様に して液晶表示素子を作製し、プレチルト角を測定 したところ48°であった。

また配向の乱れも生じなかった。

业 施 例 2

実施例1の場合と全く同様にしてガラス基板上 * にポリイミド被膜を形成し、基板の移動速度を毎 秒20mmに変えた他は実施例1と全く同様にラー ビング処理をし、セルを組み立てたところ、プレ チルト角は5.1°で変化せず、配向性も良好で あった。この時のラビング強度は実施例1のほぼ 5倍に相当する。また、実施例1と同様の熱処理 を行ったところ、プレチルト角は5.1°であり、 配向の乱れも生じなかった。

この結果から、本実施例におけるポリイミドが 非常に安定した傾斜配向を与えることが確認され 1:0

実施例3

4, 4′ - ジアミノジフェニルエーテル 0. 0 197モルを0.0175モルに、4-(1H, 1 H. 2 H, 2 H - パーフルオロデシロキシ) -1. 3 - ジアミノベンゼン 0. 0 0 2 2 モルを 0. 0044モルに変えた以外は、実施例1と全く同

実施例5

4. 4′ - ジアミノジフェニルエーテル3. 9 4g(0.0197モル)と4-ヘキサデシロキ u - 1, 3 - 97 = 1 - 400, 76g(0). 0022モル)をMMP85gに溶解させ、氷水 浴で冷却した。これにピロメリット酸二無水物 4. 78g(0.0219モル)を少しずつ加えた。 氷水浴につけたまま1時間ついで室温で2時間提 押して、ポリアミド酸の10重量%NMP溶液を 得た。

このポリアミド酸溶液を実施例1と同様に処理 して液晶表示素子を作製したところ、プレチルト 角は6.0°で、配向性も良好であった。 実施例6

ピロメリット酸二無水物 0. 02モル、3,3 ′ -ジアミノジフェニルエーテル0.0152モ ル、4 - (1 H, 1 H, 2 H, 2 H - パーフルオ ロデシロキシ) -1, 3-ジアミノベンゼン0. 004モルおよび1、3ービス(3ーアミノプロ ピル) テトラメチルジシロキサン0. 0008モ ルをNMP溶媒中で室温で3時間反応させて、ポリアミドの15重量%溶液を得た。重合繰り返し単位の構成比m/nは20/80である。この溶液をNMPとBCで7.5重量%に希釈(NMP:BC=7:3)した後、透明導電膜が形成されたガラス基板(30mm×33mm)に印刷法で塗布した。以下、実施例1と同様にして、液晶表示素子を作製し、プレチルト角を測定したところ、7.1 で液晶配向状態も良好であった。実施例7

ピロメリット酸二無水物 0. 1 モル、 2. 2 ーピス (4 ー (4 ー アミノフェノキシ) フェニルプロパン 0. 0 7 6 モル、 4 ー (1 H. 1 H. 2 H. 2 H. 7 ーパーフルオロデシロキシ) ー1. 3 ージアミノベンゼン 0. 0 2 モルおよび 1. 3 ーピス (3 ー アミノプロピル) テトラメチルジシロキサン 0. 0 0 4 モルを N M P 溶媒中で 4 0 ℃で 3 時間反応させて、ポリアミド酸溶液を調整した。 重合繰り返し単位の構成比 m / n は 2 0 / 8 0 である。この溶液を N M P と B C で 7. 5 重量%に希

0.0219モルと4,4′ージアミノジフェニルエーテル0.0219モルを0℃で1時間ついで室温で2時間撹拌して、得られたポリアミド酸の10重風%NMP溶液を作製した。プレチルト角を測定したところ、ほぼ0℃であった。

[発明の効果]

本発明は液晶配向膜を特定のポリイミドで構成したので、特殊な装置を用いることなく安定で大きなプレチルト角を持つ傾斜配向を得ることができる。これにより、STN方式のような液晶分子の傾斜配向を必要とする液晶表示素子を経済的に作製することができる。

特許出願人 東レ株式会社

釈(NMP: BC=7:3)した後、透明導電膜が形成されたガラス基板(30mm×33mm)に印刷法で塗布した。以下、実施例2と同様にして、液晶表示素子を作製しプレチルト角を測定した。この液晶表示素子を100℃に加熱した後、室温まで冷却したところ、プレチルト角は7.0で液晶配向状態も良好であった。

実施例8

2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニルプロパン0.076モルを0.05モルに、4-(1H,1H,2H,2H-パーフルオロデシロキシ)-1,3-ジアミノベンゼン0.02モルを0.05モルに変えた以外は、実施例7と全く同様にしてポリアミド酸溶液を調整した。重合繰り返し単位の構成比m/nは50/50である。以下実施例7と同様に処理して液晶表示素子を作製しプレチルト角を測定したところ11であった。

比較例1

NMPを溶媒として、ピロメリット酸二無水物

THIS PAGE BLALLIN , ...

THIS PAGE BLANK (USPTO)